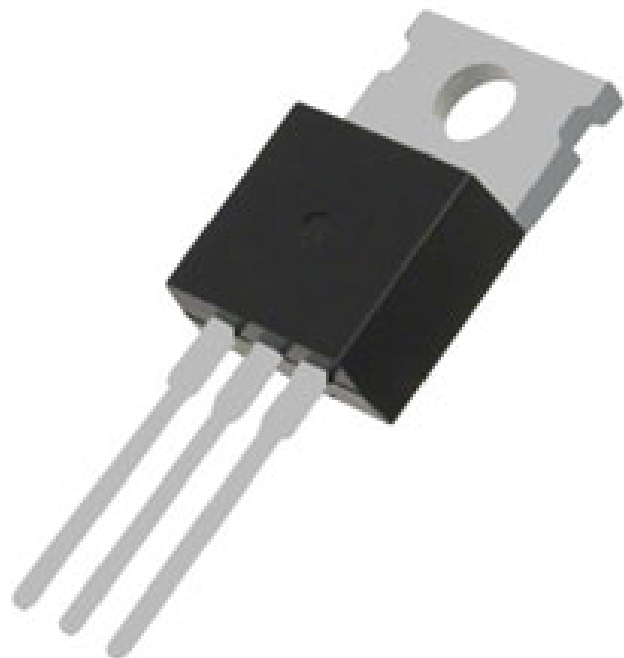


Transistor FDP61N20 Mosfet N de puissance 200V 61A 0,041 Ohms N-Channel Unifet



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVFDP61N20
-------	-------------

Illustration non contractuelle

Transistor FDP61N20 Mosfet N de puissance 200V 61A 0,041 Ohms N-Channel Unifet TO-220

Transistor FDP61N20 Mosfet N de puissance 200V 30A 0,034 Ohms N-Channel Unifet TO-220

Type de canal : Canal N

Courant de drain Id : 61A

Tension Vds max.. : 200V

Résistance Drain-Source à I_D'état-ON : 0.034ohm

Résistance Rds(on) : 0.034ohm

Tension de test Rds(on) : 10V

Montage transistor : Traversant

Tension de seuil Vgs Max : 5V

Dissipation de puissance Pd : 417W

Type de boîtier de transistor : TO-220

Nombre de broches : 3Broche(s)

Dissipation de puissance : 417W

Température de fonctionnement max.. : 150°C

Packaging :

PROZIC.com



PROZIC

113 Ancienne route Imperiale

31120 Portet-sur-Garonne

05 82 950 710

Dimensions produit :

Données non contractuelles